

تعداد سوال: نفر ۲۰ تکمیلی — شریعی ۴

زمان امتحان: نظری و تکمیلی ۶۰ دقیقه شریعی ۶۰ دقیقه

تعداد کل صفحات: ۴

* استفاده از ماشین حساب مجاز است.

۱. رسانش الکتریکی در یک نیمرسانا نوع P توسط کدامیک از ساز و کار زیر اتفاق می‌افتد؟الف. انتقال حفره‌های باردار مثبت با جرم مؤثر m_h در نوار ظرفیتب. انتقال الکترونهای باردار منفی با جرم مؤثر m_e در نوار ظرفیتج. انتقال حفره‌های باردار مثبت با جرم آزاد m_h در نوار رسانشد. انتقال الکترونهای باردار منفی با جرم آزاد m_e در نوار رسانش

۲. اگر یک عنصر سه ظرفیتی آلومینیم را به عنوان اتم جانشین به کار ببریم پیکربندی پیوند، یک الکترون کم خواهد داشت در نتیجه در ساختار بلوری سیلیسیم که یک اتم سیلیسیم با یک اتم آلومینیم حایگزین شده:

الف. همراه باز مثبت غیرمتحرک باقیمانده در اتم ناخالص یک حفره تولید می‌شود.

ب. تعداد حفره‌ها بیشتر از اتم‌های ناخالص است و یونش کامل است.

ج. همراه باز منفی غیرمتحرک باقیمانده در اتم ناخالص یک حفره تولید می‌شود.

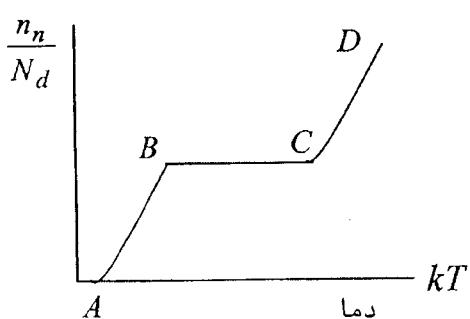
د. اتم ناخالص آلومینیم در سیلیسیم حفره می‌پذیرد تا الکترون تولید کند.

۳. حاصلضرب Pn در یک نیمرسانا و تحت تعادل گرمایی به کدام کمیت بستگی دارد؟

الف. چگالی ناخالصی

ب. مکان تراز فرمی

ج. چگالی حالت‌های انرژی مجاز و انرژی گاف ممنوع

۴. در نمودار چگالی الکترون به صورت تابعی از دما در سیلیسیم نوع n ، ناحیه AB ، BC و CD به ترتیب کدام است؟

الف. یونش - ذاتی - غیرذاتی

ب. یونش - غیرذاتی - ذاتی

ج. ذاتی - غیرذاتی - یونش

د. غیرذاتی - یونش - ذاتی

$$5. \text{ چگالی پذیرنده‌های یونیده } N_a^- \text{، با حالت‌های اشغال شده پذیرنده برابر است با:}$$

$$N_a^- = \frac{N_a}{A} \frac{1}{1 + \frac{1}{e^{kT}}}$$

در این رابطه A برابر است با:

$E_a - E_f$

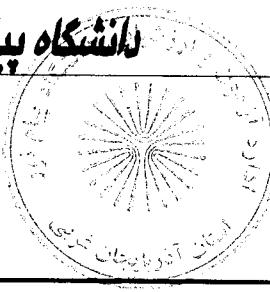
$E_d - E_f$

$E_a + E_f$

$E_d + E_f$

۱

تعداد سوال: نهضت ۲۰ تکمیلی - نظری ۴
 زمان امتحان: نستی و تکمیلی ۶۰ دقیقه نظری ۶۰ دقیقه
 تعداد کل صفحات: ۴



۶. برای سیلیسیم نوع n با مرکزی واقع در E_i , اگر $p_n - p_{n_0} = 2k$ باشد، آهنگ بازنگیب خالص برای تزریق کم برابر است با:

$$\text{الف. } \frac{c_p N_t}{2k} \quad \text{ج. } \frac{2k c_p}{N_t} \quad \text{ب. } \frac{1}{2} k c_p N_t \quad \text{د. } 2k c_p N_t$$

۷. در آزمایش واپاشی فوتورسانندگی، ولتاژی که توسط نوسان نما اندازه گرفته می‌شود با کدام کمیت به طور مستقیم متناسب است؟ ($R \gg R_s$)

$$\text{الف. } R \quad \text{ب. } \frac{1}{R_s} \quad \text{ج. } \frac{1}{\sigma} \quad \text{د. } V$$

۸. حاصلضرب $c N_{ts}$ دارای چه بعدی است؟ (در بازنگیب سطحی)

- الف. ژول بر ثانیه
 ب. سانتی متر بر ثانیه
 ج. ولت بر متر
 د. سانتی متر ثانیه

۹. اگر در نیمرسانی ناهمگن $N_d(x) = 2n_i$ باشد، انرژی E_i برابر است با:

$$\text{الف. } E_f + 2k T \ln 2 \quad \text{ب. } E_f - k T \ln 2 \quad \text{ج. } E_f - 2k T \ln 2$$

۱۰. ناحیه تهی در پیوندگاه $P - n$ جایی است که:

- الف. بارهای ثابت وجود دارند، اما حاملهای آزاد وجود ندارند.
 ب. چگالی بار فضایی کل صفر است.

$$\text{ج. معادله } \frac{d^3\psi}{dx^3} = 0 \text{ برقرار است.}$$

$$\text{د. معادله } \frac{d^3\psi}{dx^3} = \frac{qN_a}{k\varepsilon_0} \text{ برقرار است.}$$

۱۱. در یک پیوندگاه با پیش ولت مخالف، در لایه بار فضایی کدام وضعیت برقرار است؟

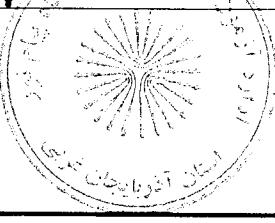
$$\text{الف. } Pn = n_i^3 \quad \text{ب. } Pn > n_i^3 \quad \text{ج. } Pn < n_i^3 \quad \text{د. } P - n = n_i^3$$

برترین مرکز فروش نووار الات از مدرسۀ دکتر ربابا خضری و تیرخس
 خرید و فروش کتابهای دانگاه پیام نور. ارائه کلیه خدمات دانشجویی

فشر تری

متغیری
 متفاوت بیانیشیم، گزینه هیچکدام را تیک بزنیم

آدرس: مکان راسان شهید رجایی، تلفن: ۰۳۱۵۹۸۳۳۷۷ - ۰۳۱۵۸۷۶۷۷، نوش تک،



تعداد سوال: نسخه ۲۰ تکمیلی — تشریحی ۴
 زمان امتحان: نسخه تکمیلی ۶۰ نسبه تشریحی ۶۰ نسبه
 تعداد کل صفحات: ۴

۱۲. اگر V_T , دو برابر شود، ظرفیت پخشی چند برابر می‌شود؟

- الف. چهار برابر ج. نصف ب. دو برابر د. یک چهارم

۱۳. در دیود بازیافت پله‌ای، توزیع ناخالصی در ناحیه پیوندگاه:

- ب. بار انباشته شده صفر می‌شود.
 د. میدان ترمیزی از بین می‌رود.
 الف. یک میدان ترمیزی ایجاد می‌کند.
 ج. بارانباشتہ افزایش می‌یابد.

۱۴. برای بهینه شدن کارآیی باتری خورشیدی باید:

- ب. I_{mp} بزرگ و V_{mp} کوچک باشد.
 د. I_{mp} بزرگ و V_{mp} برابر صفر باشد.
 الف. I_{mp} کوچک و V_{mp} بزرگ باشد.
 ج. I_{mp} و V_{mp} هر دو بزرگ باشد.

۱۵. در مقایسه با باتری پیوندگاه $n - P$, باتری سدشوستکی:

- الف. دارای ولتاژ مدار باز بیشتری است و لذا کارآیی آن بیشتر است.
 ب. دارای ولتاژ مدار باز کمتری است و لذا کارآیی آن بیشتر است.
 ج. دارای ولتاژ مدار باز کمتری است و لذا کارآیی آن کمتر است.
 د. دارای ولتاژ مدار باز بیشتری است و لذا کارآیی آن کمتر است.

۱۶. عیوب استفاده از دیود گنبدی برای بازتاب داخلی چیست؟

- الف. عملیات ماشین کاری آن مقرر به صرفه نیست.
 ب. طول پیوندگاه زیاد است.
 ج. کیفیت دیود بسیار پایین است.
 د. دیود گنبدی به تابش نور حساس نیست.

۱۷. کدام گزینه در مورد گسیلندهای $GaAs$ درست است؟

- الف. گسیل در ناحیه سبز است و به عنوان جداساز نوری کاربرد دارد.
 ب. گسیل در ناحیه فروسرخ است و به عنوان جداساز نوری کاربرد دارد.
 ج. گسیل در ناحیه فروسرخ است و به عنوان دیود تونلی کاربرد دارد.
 د. گسیل در ناحیه فروسرخ است و به عنوان دیود ایساکی کاربرد دارد.

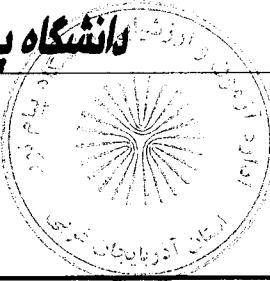
۱۸. در نقطه تنگش:

- الف. نواحی بار فضایی از هم جدا می‌شوند.
 ب. حاملهای آزاد در ناحیه وصل شده ایجاد می‌شوند.
 د. عرض کانال بسیار زیاد می‌شود.
 ج. عرض لایه بار فضایی برابر عرض کانال است.

۱۹. ترارسانایی عرضی مؤثر برای مقادیر R_s $g_m R_s$ خیلی کوچک برابر است با:

$$R_s \quad g_m$$





نام درس: فیزیک قطعات نیمه رسانا ۱

رشته تحصیلی - گرایش: فیزیک

کد درس: ۲۱۱۴۴۶

تعداد سوال: نسخه ۲۰ تکمیلی -- تشریحی ۴
 زمان امتحان: تشریحی و تکمیلی ۶۰ دقیقه تشریحی ۶۰ دقیقه
 تعداد کل صفحات: ۴

۲۰. بسامد قطع ω_α برابر است با:

الف. بسامد قطع گسیلنده - مشترک

$$\frac{1}{\tau_E}$$

$$\frac{1}{\tau_B} + \frac{1}{\tau_E}$$

د. معکوس تأخیر زمانی کلی است که در انتشار سیگنال از گسیلنده به گردآور پیش آمد

سؤالات تشریحی

۱. چگالی حالت‌های قابل دسترس در نوار رسانش به صورت زیر است:

$$N(E) = \frac{4\pi}{h^3} (2m_e)^{\frac{3}{2}} (E - E_c)^{\frac{1}{2}}$$

که در آن h ثابت پلانک است. تعداد کل الکترونها در نوار رسانش را محاسبه کنید.۲. برای یک نیمرسانا با داده‌های زیر ترازهای فرمی‌وار برای الکترونها و حفره‌ها را بدست آورید. (محاسبه را در دمای اتاق $K = 300$ انجام دهید.)

$$G_L = 10^{17} \text{ cm}^{-3} \text{ s}^{-1}$$

$$n_i = 10^9 \text{ cm}^{-3}$$

$$\tau_n = 12 \mu\text{s}$$

$$N_a = 10^{15} \text{ cm}^{-3}$$

۳. کارآیی کوانتومی خارجی را تعریف و روابط مربوطه را بنویسید و توضیح دهید.

۴. شکست بهمنی را بیان کنید و رابطه عامل تکثیر بهمنی با کمیت‌ها را بنویسید و توضیح دهید.